



## 产品特点

高精度MEMS工艺制备  
高性能，低温漂，小体积  
陶瓷基板，50Ω共面波导  
金丝键合，适用于多芯片集成模块

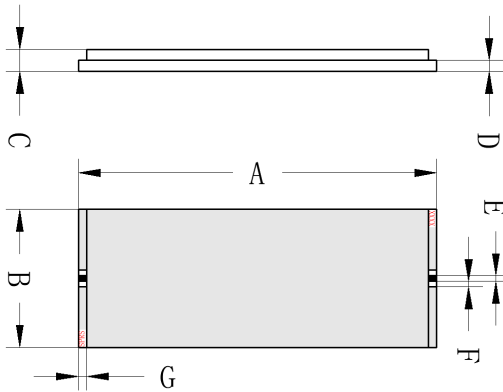
## 技术要求

| 项目    | 参数              | 单位  |
|-------|-----------------|-----|
| 中心频率  | 3.9             | GHz |
| 工作带宽  | 3.75-4.05       | GHz |
| 中心损耗  | 3.7             | dB  |
| 带内波动  | 1.0             | dB  |
| 驻波比   | 1.7:1           |     |
| 群时延波动 | 1.0             | ns  |
| 带外抑制  | 40@DC-3.35GHz   | dBc |
| 带外抑制  | 40@4.45-10.5GHz | dBc |

## 其它要求：设计保证

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 承受功率 | <4W CW                                            |
| 工作温度 | -55~+85°C                                         |
| 储存温度 | -55~+125°C                                        |
| 外形尺寸 | A:7.0, B:7.0, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.67 |

## 外形图：端口居中



## 推荐装配图

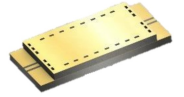


|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 电路板Rogers5880, h: 0.254mm<br>适用频率: 10~40GHz | 电路板Rogers5880, h: 0.127mm<br>适用频率: 10~70GHz |
|                                             |                                             |

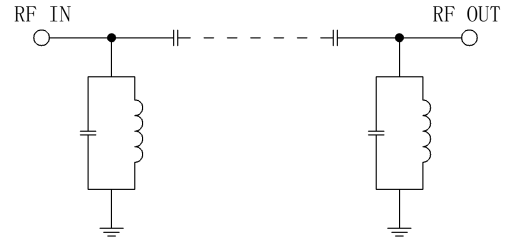
## 注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

## 参考实物图



## 原理图



## 典型曲线

